

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2004-103786

(43)Date of publication of application : 02.04.2004

(51)Int.CI.

H01L 21/338

H01L 21/822

H01L 27/04

H01L 27/095

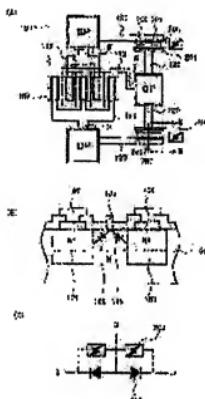
H01L 29/812

(21)Application number : 2002-262845 (71)Applicant : SANYO ELECTRIC
CO LTD

(22)Date of filing :

09.09.2002 (72)Inventor : ASANO TETSUO
SAKAKIBARA
MIKITO
HIRAI TOSHIKAZU

(54) SEMICONDUCTOR DEVICE



(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an electrostatic breakdown protecting element 200 which can remarkably improve the electrostatic breakdown voltage without deteriorating the microwave characteristic of a GaAsMESFET, because a PN junction is not included and the maximum capacitance is about several tens of fF or less.

SOLUTION: The semiconductor device comprises a gate electrode, a source electrode and a drain electrode connected at the surface of operating region provided on a substrate, an FET as the element to be protected including a gate terminal, a source terminal and a drain terminal connected to each electrode, and a protection

terminal and a drain terminal connected to each electrode, and a protection

element which is connected in parallel between two terminals of the element to be protected and provides an insulated region between two terminals of a first high concentration impurity region and a second high concentration impurity region. Moreover, in the semiconductor device electrostatic energy applied between the two terminals of the element to be protected is discharged between the first and second high concentration impurity regions, and electrostatic energy reading the two electrodes corresponding to two terminals of the element to be protected is reduced in such a degree not exceeding the electrostatic breakdown voltage between the two electrodes described above.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 08.09.2005

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁(JP)

(12)公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開2004-103786

(P2004-103786)

(43)公開日 平成16年4月2日(2004.4.2)

(51)Int.Cl.⁷H01L 21/338
H01L 21/822
H01L 27/04
H01L 27/095
H01L 29/812

F I

H01L 29/80
H01L 29/80
H01L 27/04

P

E

H

テーマコード(参考)

5FO38

5F102

審査請求 未請求 請求項の数 46 O.L (全 25 頁)

(21)出願番号

特願2002-262845(P2002-262845)

(22)出願日

平成14年9月9日(2002.9.9)

(71)出願人 000001889

三洋電機株式会社

大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号

(74)代理人 100111383

弁理士 芝野 正雅

(72)発明者

浅野 哲郎

大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三

洋電機株式会社内

(72)発明者

神原 幹人

大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三

洋電機株式会社内

(72)発明者

平井 利和

大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三

洋電機株式会社内

最終頁に続く

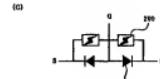
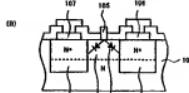
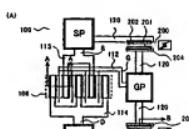
(54)【発明の名称】半導体装置

(57)【要約】

【課題】マイクロ波FETでは、内在するショットキ接合容量またはPN接合容量が小さく、それらの接合が静電気に弱い。しかし、マイクロ波デバイスにおいては、保護ゲイオードを接続することによる寄生容量の増加が、高周波特性の劣化を引き起すので、その手法を取ることができなかつたという問題があつた。

【解決手段】FETの2端子間に第1N+型領域、第2N+型領域からなる保護素子を並列に接続する。近接した第1、第2N+領域間で放電できるので、寄生容量を増やすことなくFETの動作領域に至る静電エネルギーを減衰させることができます。

【選択図】 図1



【特許請求の範囲】

【請求項 1】

基板上に設けた動作領域表面に接続するゲート電極、ソース電極およびドレイン電極と、各電極に接続するゲート端子、ソース端子、ドレイン端子とを有する被保護素子となるFETと、

前記被保護素子のいずれか2つの端子間に並列に接続され、第1の高濃度不純物領域と第2の高濃度不純物領域の2端子間に絶縁領域を配置した保護素子とを有し、

前記被保護素子の2つの端子間に印加される静電エネルギーを前記第1および第2の高濃度不純物領域間で放電させ、前記被保護素子の2つの端子に対応する前記2つの電極に到達する静電エネルギーを前記2つの電極間の静電破壊電圧を超えない程度に減衰させることを特徴とする半導体装置。 10

【請求項 2】

前記被保護素子の、静電破壊電圧を前記保護素子の接続前と比較して20V以上向上させることを特徴とする請求項1に記載の半導体装置。

【請求項 3】

前記保護素子は、前記被保護素子の端子の少なくとも1つと近接して配置することを特徴とする請求項1に記載の半導体装置。

【請求項 4】

前記保護素子は、前記被保護素子の1つの端子から該被保護素子の動作領域へ向かう経路途中に接続することを特徴とする請求項1に記載の半導体装置。 20

【請求項 5】

1つの前記保護素子は、前記被保護素子の端子と接続するポンディングパッドの少なくとも一辺に沿って配置されることを特徴とする請求項1に記載の半導体装置。

【請求項 6】

前記保護素子は複数設けられ、前記被保護素子の端子と接続する1つのポンディングパッドの少なくとも一辺に沿ってそれぞれ配置されることを特徴とする請求項1に記載の半導体装置。

【請求項 7】

前記保護素子は、前記ポンディングパッドの辺に沿って10μm以上の長さで配置されることを特徴とする請求項5または請求項6に記載の半導体装置。 30

【請求項 8】

前記第1の高濃度不純物領域は、被保護素子の1つの端子と接続するポンディングパッドまたはポンディングパッドに接続する配線と接続することを特徴とする請求項1に記載の半導体装置。

【請求項 9】

前記第1の高濃度不純物領域は、前記被保護素子の1つの端子と接続するポンディングパッドと前記1つの電極とを接続する接続手段の一部であることを特徴とする請求項1に記載の半導体装置。

【請求項 10】

前記第2の高濃度不純物領域は、前記被保護素子の他の端子と接続するポンディングパッド又は該ポンディングパッドに接続する配線と接続することを特徴とする請求項1に記載の半導体装置。 40

【請求項 11】

前記第2の高濃度不純物領域は、前記被保護素子の他の端子と接続するポンディングパッド又は該ポンディングパッドに接続する配線の、周辺に設けられた第3の高濃度不純物領域の一部であることを特徴とする請求項1に記載の半導体装置。

【請求項 12】

前記保護素子は、前記被保護素子の他の端子と接続するポンディングパッドにそれぞれ近接して複数設けられ、前記複数の保護素子の第1の高濃度不純物領域は、被保護素子の端子と動作領域とを接続する接続手段の一部であることを特徴とする請求項1に記載の半導体装置。 50

体装置。

【請求項 1 3】

基板上の動作領域表面に接続するソース電極、ゲート電極およびドレイン電極を設けた第1および第2のFETを形成し、両FETに共通のソース電極あるいはドレイン電極に接続する端子を共通入力端子とし、両FETのドレイン電極あるいはソース電極に接続する端子をそれぞれ第1および第2の出力端子とし、両FETのゲート電極のいずれかが接続する端子をそれぞれ第1および第2の制御端子とし、前記両制御端子に印加して、前記両制御端子と前記ゲート電極とを接続する接続手段である抵抗を介していずれか一方のFETを導通させて前記共通入力端子と前記第1および第2の出力端子のいずれか一方と信号経路を形成するスイッチ回路装置を被保護素子とし、前記被保護素子の少なくとも1つの前記制御端子と前記入力端子間に並列に接続され、第1の高濃度不純物領域と第2の高濃度不純物領域の間に絶縁領域を配置した保護素子とを有し、

前記少なくとも1つの制御端子と前記共通入力端子間に、外部より印加される静電エネルギーを前記第1および第2の高濃度不純物領域間で放電させ、前記少なくとも1つの制御端子および共通入力端子にそれぞれ対応する電極間に到達する静電エネルギーを前記電極間の静電破壊電圧を超えない程度に減衰させることを特徴とする半導体装置。

【請求項 1 4】

前記共通入力端子と前記1つの制御端子間の静電破壊電圧を前記保護素子の接続前と比較して20V以上向上させるこことを特徴とする請求項1 3に記載の半導体装置。

10

【請求項 1 5】

前記被保護素子の少なくとも1つの前記制御端子と少なくとも1つの前記出力端子間に並列に保護素子を接続し、被保護素子の静電破壊電圧を前記保護素子の接続前と比較して20V以上向上させるこことを特徴とする請求項1 3に記載の半導体装置。

20

【請求項 1 6】

前記保護素子は、少なくとも前記共通入力端子と近接して配置することを特徴とする請求項1 3に記載の半導体装置。

【請求項 1 7】

前記保護素子は、前記少なくとも1つの制御端子から前記ゲート電極へ向かう経路途中に接続することを特徴とする請求項1 3に記載の半導体装置。

30

【請求項 1 8】

前記保護素子は、前記共通入力端子が接続するポンティングパッドの少なくとも一辺に沿って配置されることを特徴とする請求項1 3に記載の半導体装置。

【請求項 1 9】

前記保護素子は、前記少なくとも1つの出力端子が接続するポンティングパッドの少なくとも一辺に沿って配置されることを特徴とする請求項1 3に記載の半導体装置。

【請求項 2 0】

前記保護素子は複数設けられ、前記共通入力端子が接続するポンティングパッドの少なくとも一辺に沿ってそれぞれ配置されることを特徴とする請求項1 3に記載の半導体装置。

40

【請求項 2 1】

前記保護素子は、1.0μm以上の長さで配線されることを特徴とする請求項1 8または請求項1 9または請求項2 0に記載の半導体装置。

【請求項 2 2】

前記第1の高濃度不純物領域は、前記少なくとも1つの制御端子が接続するポンティングパッドまたはポンディングパッドに接続する配線と接続することを特徴とする請求項1 3に記載の半導体装置。

【請求項 2 3】

前記第1の高濃度不純物領域は、前記少なくとも1つの制御端子が接続するポンディングパッドと前記ゲート電極とを接続する抵抗の一部であることを特徴とする請求項1 3に記載の半導体装置。

50

【請求項 24】

前記第 2 の高濃度不純物領域は、前記共通入力端子が接続するボンディングパッド又はボンディングパッドに接続する配線と接続することを特徴とする請求項 1 に記載の半導体装置。

【請求項 25】

前記第 2 の高濃度不純物領域は、前記共通入力端子のボンディングパッド又はボンディングパッドに接続する配線の、周辺に設けられた第 3 の高濃度不純物領域の一部であることを特徴とする請求項 1 に記載の半導体装置。

【請求項 26】

前記保護素子は、前記共通入力端子が接続するボンディングパッドおよび少なくとも 1 つ 10 の前記出力端子が接続するボンディングパッドにそれぞれ近接して複数設けられ、前記複数の保護素子の第 1 の高濃度不純物領域は、前記少なくとも 1 つの制御端子と前記ゲート電極を接続する抵抗の一部であることを特徴とする請求項 1 に記載の半導体装置。

【請求項 27】

前記被保護素子の静電破壊電圧を 200V 以上にすることを特徴とする請求項 1 または請求項 1 に記載の半導体装置。

【請求項 28】

前記被保護素子と前記保護素子とを同一チャップに集積化することを特徴とする請求項 1 または請求項 1 に記載の半導体装置。

【請求項 29】

前記保護素子の第 1 および第 2 の高濃度不純物領域は静電エネルギーを通すことのできる距離で離間することを特徴とする請求項 1 または請求項 1 に記載の半導体装置。

20

【請求項 30】

前記第 1 および第 2 の高濃度不純物領域は 0.5 μm から 1.0 μm の離間距離で配置されることを特徴とする請求項 2 に記載の半導体装置。

【請求項 31】

前記第 1 および第 2 の高濃度不純物領域は同じ導電型の不純物領域であることを特徴とする請求項 1 または請求項 1 に記載の半導体装置。

【請求項 32】

前記第 1 および第 2 の高濃度不純物領域は異なる導電型の不純物領域であることを特徴とする請求項 1 または請求項 1 に記載の半導体装置。

【請求項 33】

前記第 1 および第 2 の高濃度不純物領域の不純物濃度はともに $1 \times 10^{17} \text{ cm}^{-3}$ 以上であることを特徴とする請求項 1 または請求項 1 に記載の半導体装置。

30

【請求項 34】

前記絶縁領域は基板に設けられた不純物注入領域であることを特徴とする請求項 1 または請求項 1 に記載の半導体装置。

【請求項 35】

前記絶縁領域は半絶縁基板の一部であることを特徴とする請求項 1 または請求項 1 に記載の半導体装置。

40

【請求項 36】

前記絶縁領域の不純物濃度は $1 \times 10^{14} \text{ cm}^{-3}$ 以下であることを特徴とする請求項 1 または請求項 1 に記載の半導体装置。

【請求項 37】

前記絶縁領域の抵抗率は $1 \times 10^8 \Omega \text{ cm}$ 以上であることを特徴とする請求項 1 または請求項 1 に記載の半導体装置。

【請求項 38】

前記第 1 および第 2 の高濃度不純物領域の少なくとも一方は金属電極と接続することを特徴とする請求項 1 または請求項 1 に記載の半導体装置。

【請求項 39】

50

前記金属電極は、前記被保護素子の端子と接続するボンディングパッドまたは該ボンディングパッドに接続する配線と接続することを特徴とする請求項38に記載の半導体装置。
【請求項40】

前記金属電極は、前記第1および第2の高濃度不純物領域の少なくとも一方とオーミック接合を形成することを特徴とする請求項38に記載の半導体装置。
【請求項41】

前記金属電極は、前記第1および第2の高濃度不純物領域の少なくとも一方とショットキ接合を形成することを特徴とする請求項38に記載の半導体装置。
【請求項42】

前記金属電極は、前記絶縁領域端部から0.1μmから5μm離隔して前記第1および／または第2の高濃度不純物領域表面に設けられることを特徴とする請求項40または請求項41に記載の半導体装置。
【請求項43】

前記金属電極の一部は、前記基板に延在され該基板表面とショットキ接合を形成することを特徴とする請求項38に記載の半導体装置。
【請求項44】

前記金属電極は、前記第1および／または第2の高濃度不純物領域上に絶縁膜を介して設けられることを特徴とする請求項43に記載の半導体装置。
【請求項45】

前記金属電極は第1および／または第2の高濃度不純物領域端部から0μmから5μm外側で前記基板表面とショットキ接合を形成することを特徴とする請求項38に記載の半導体装置。
【請求項46】

前記FETは、MESFET、接合型FETまたはHEMTであることを特徴とする請求項1または請求項13に記載の半導体装置。
【請求項47】

前記FETの動作層は不純物注入領域であることを特徴とする請求項1および請求項13に記載の半導体装置。
【請求項48】

前記FETの動作層は不純物を含むエピタキシャル層であることを特徴とする請求項1および請求項13に記載の半導体装置。
【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、半導体装置、特に静電破壊電圧を大幅に向上させた半導体装置に関する。

【0002】

【従来の技術】

衛星放送受信機の出現に始まった一般民生用マイクロ波機器市場は、携帯電話の世界的な普及と規模が一挙に拡大し、今新たに、無線プロードバンド用途の市場が本格的に始まるとしている。それらの市場には、マイクロ波用に適したガリウム・素(GaAs)デバイス、従来のSiデバイスを微細化、立体構造化して低寄生容量化、低寄生抵抗化を図ったSiマイクロ波デバイスが主に使用されている。

【0003】

図13は、化合物半導体Siイチ回路装置を示す回路図である。第1のFET1と第2のFET2のソース電極(あるいはドレン電極)が共通入力端子INに接続され、FET1およびFET2のゲート電極がそれぞれ抵抗R1、R2を介して第1と第2の制御端子C71-1、C71-2に接続され、そしてFET1およびFET2のドレン電極(あるいはソース電極)が第1と第2の出力端子OUT1、OUT2に接続されたものである。第1と第2の制御端子C71-1、C71-2に印加される制御信号は相補信号であり、Hレベルの信号が印加された側のFETがONして、共通入力端子INに印加された入

10

20

30

40

50

力信号をどちらか一方の出力端子に伝達するようになってくる。抵抗R-1、R-2は、交流接続となり制御端子C71-1、C71-2の直列電位に対してゲート電極を介して高周波信号が漏出することを防止する目的で配置されている。

【0004】

図14は、この化合物半導体スイッチ回路装置を集積化した化合物半導体チップの1例を示している。

【0005】

GaN基板にスイッチを行うFET1およびFET2を中央部に配置し、各FETのゲート電極に抵抗R1、R2が接続されている。また共通入力端子IN、出力端子OUT1、OUT2、制御端子C71-1、C71-2に対応するパッドが基板の周辺に設けられている。なお、点線で示した第2層目の配線は各FETのゲート電極形成時に同時に形成されるゲート金属層(Ti/Pt/Au)20であり、実線で示した第3層目の配線は各元素の接続およびパッドの形成を行なうパッド金属層(Ti/Pt/Au)80である。第1層目の基板にオーミックに接触するオーミック金属層(AuGe/Ni/Au)は各FETのソース電極、ドレイン電極および各抵抗両端の取り出し電極を形成するものであり、図14では、パッド金属層と重なるために図示されていない。

【0006】

図14に示したFET1は一点銀線で囲まれる長方形形状の動作領域12に形成される。下側から伸びる柳歯状の3本の第3層目のパッド金属層80が出力端子OUT1に接続されるソース電極18(あるいはドレイン電極)であり、この下に第1層目オーミック金属層10で形成されるソース電極14(あるいはドレイン電極)がある。また上側から伸びる柳歯状の3本の第3層目のパッド金属層80が共通入力端子INに接続されるドレイン電極15(あるいはソース電極)であり、この下に第1層目のオーミック金属層で形成されるドレイン電極14(あるいはソース電極)がある。この両電極は柳歯をかみ合わせた形状に配置され、その間に第2層目のゲート金属層20で形成されるゲート電極17が動作領域12上に4本の柳歯形状に配置されている。なお、上側から伸びる真中の柳歯のドレイン電極15(あるいはソース電極)はFET1とFET2とで共用しており、更に小型化に寄与している。ここで、ゲート幅が600μmという意味は各FETの柳歯状のゲート電極17のゲート幅の総和がそれぞれ600μmであることを示している。

【0007】

上述の如く、従来のスイッチ回路装置においては、特に静電破壊を保護する対応がなされていない(例えば、
【非特願文献1】参照。)。

【0008】

【非特許文献1】

特願2000-141387号

【0009】

【発明が解決しようとする課題】

図15に、図14に示すスイッチ回路装置の静電破壊電圧を測定した結果を示す。ここで、静電破壊電圧の測定は、以下の条件により行ったものである。220PFの試験用容量の両端に試験用電圧を印加し、試験用容量に電荷を蓄積した後、電圧印加のための配線を遮断する。その後、試験用容量に蓄積された電荷を被試験素子(FET)の両端に抵抗成分およびインダクタ成分を付加しない状態で放電し、その後FETが破壊していかないかどうか測定する。破壊していかなければ印加電圧を10Vずつ上げて試験を繰り返し、FETが破壊に至る最初の印加電圧を静電破壊電圧として測定したものである。

【0010】

この図からも明らかのように、従来では静電破壊電圧向上のための対策を施していないため、特に制御信号が印加される共通入力端子IN-制御端子C71-1間、共通入力端子IN-制御端子C71-2間の静電破壊電圧が共に140Vしかなく最も低い。

【0011】

10

20

80

40

50

また、静電破壊電圧はどの端子間の値がによりばらつきがある。この静電破壊電圧を決める詳細なメカニズムは不明であるが、スイッチ回路装置においては、最も低い静電破壊電圧を示す2端子間の値は、一般的には、上述の如く1000V程度以下であり、取り扱いに細心の注意が必要であった。すなわち、最も低い静電破壊電圧となる端子間の値がその素子全体の静電破壊電圧に支配的となるため、この端子間の静電破壊電圧を向上させることが課題である。

【0012】

また、この例に限らず、これらのマイクロ波通信用デバイスは、他の音響用、映像用、電源用デバイスと異なり、これらのデバイスに内在するショットキ接合またはPN接合容量が小さく、それらの接合が静電気に弱いという問題があった。

10

【0013】

一般に静電気がデバイスを保護するには、静電破壊しやすい、PN接合、ショットキ接合を含むデバイスに、静電破壊保護ゲイオードを並列に接続するという手法が考えられる。しかし、マイクロ波デバイスにおいては、保護ゲイオードを接続することによる寄生容量の増加が、高周波特性の劣化を招き、その手法を取ることはできなかつた。

【0014】

【課題を解決するための手段】

本発明は上述した諸々の事柄に鑑み成されたもので、第1に、基板上に設けた動作領域表面に接続するゲート電極、ソース電極およびドレイン電極と、各電極に接続するゲート端子、ソース端子、ドレイン端子とを有する被保護素子となるFETと、前記被保護素子のいずれか2つの端子間に並列に接続され、第1の高濃度不純物領域と第2の高濃度不純物領域の2端子間に絶縁領域を配置した保護素子とを有し、前記被保護素子の2つの端子間に印加される静電エネルギーを前記第1および第2の高濃度不純物領域間で放電させ、前記被保護素子の2つの端子に対応する前記2つの電極に到達する静電エネルギーを前記2つの電極間の静電破壊電圧を超えない程度に減衰させることにより、解決するものである

20

【0015】

第2に、基板上の動作領域表面に接続するソース電極、ゲート電極およびドレイン電極を設けた第1および第2のFETを形成し、両FETに共通のソース電極あるいはドレイン電極に接続する端子を共通入力端子とし、両FETのドレイン電極あるいはソース電極に接続する端子をそれぞれ第1および第2の出力端子とし、両FETのゲート電極に接続する端子をそれぞれ第1および第2の制御端子とし、前記両制御端子に制御信号を印加して、前記両制御端子と前記ゲート電極とを接続する接続手段である抵抗を介していずれか一方のFETを導通させて前記共通入力端子と前記第1および第2の出力端子のいずれか一方と信号経路を形成するスイッチ回路装置を被保護素子とし、前記被保護素子の少なくとも1つの前記制御端子と前記入力端子間に並列に接続され、第1の高濃度不純物領域と第2の高濃度不純物領域の間に絶縁領域を配置した保護素子とを有し、前記少なくとも1つの制御端子と前記共通入力端子間に、外部より印加される静電エネルギーを前記第1および第2の高濃度不純物領域間で放電させ、前記少なくとも1つの制御端子および共通入力端子にそれぞれ対応する電極間に到達する静電エネルギーを前記電極間の静電破壊電圧を超えない程度に減衰させることを特徴とすることにより解決するものである。

30

【0016】

【発明の実施の形態】

以下に本発明の実施の形態を詳細に説明する。

40

【0017】

まず、図1から図8を用いて、本発明の第1の実施の形態としてGaASME8FETを例に説明する。

【0018】

図1は、第1の実施形態を示す概要図であり、図1(A)は平面図、図1(B)は図1(A)のA-A線断面図であり、図1(C)は図1(A)の等価回路図である。このように

50

本発明の半導体装置は、被保護素子100と、保護素子200とから構成される。

【0019】

図1(A) (B)のごとく、被保護素子100は、MESFETであり、半絶縁基板101であるGaAs表面に設けた動作層102とショットキ接合を形成するゲート電極105と、動作層102両端に設けた高濃度不純物領域からなるソース領域108およびドレイン領域104と、その表面にオーミック接合を形成するソース電極106およびドレン電極107とを有する。ここで、各電極が接続する動作層102、ソースおよびドレン領域103、104をFETの動作領域108と称し、図1(A)では破線で示す。

【0020】

本明細書においては、FET動作領域108内のゲート電極105、ソース電極106、ドレン電極107は、ゲート配線112、ソース配線113、ドレン配線114を介してゲートパッドGP、ソースパッドSP、ドレンパッドDPとそれぞれ接続する、とする。また、ゲート配線112、ソース配線113、ドレン配線114が集積し、対応する各パッドに至る部分をゲート端子G、ソース端子S、ドレン端子Dと称する。

【0021】

端子について、ここでの図示は省略するが、被保護素子100に、ゲートパッドGP、ソースパッドSP、ドレンパッドDPすべてを具備していないともよく、パッドは配置されていなければ端子は存在する場合を含むとする。例えば、2個のFETを集積化した段アソブMIMICにおいては、前段FETのドレンと後段FETのゲートには、パッドは存在しないが端子は存在する、というような場合である。

20

【0022】

各配線112、113、114は金属配線に限らず、N+層による抵抗などを含む。また動作領域108内の各電極に対応する各ボンディングパッドSP、DP、GPは、一様な配線だけにより接続しているとは限らず、配線途中に抵抗や容量、イングクタなどが挿入されている場合も含む。すなわちDC、AC、高周波、何らかの電気的信号か、各動作領域内108の電極と相当する各ボンディングパッドの間を伝わる、すべての場合を含むとする。

【0023】

ここでは一例として、ゲート電極105、ソース電極106およびドレン電極107はそれぞれ金属配線112、113、114により延在されゲートパッドGP、ソースパッドSP、ドレンパッドDPと接続する、とする。

30

【0024】

MESFETにおいては、ゲートショットキ接合の容量が小さく、ゲート端子G-ソース端子S間またはゲート端子G-ドレン端子D間に、ゲート端子G側をマイナスにしてサージ電圧を印加する場合が最も静電破壊に弱い。この場合、動作領域108と動作領域108表面に設けられたゲート電極105との界面に形成されるショットキバリアダイオード115に対して逆バイアスに静電気が印加される状態となる。

【0025】

図1(B) (C)の如く、GaAs MESFET100において、静電破壊電圧を考えるときはゲートショットキ接合は逆バイアス状態である。つまり、そのときの等価回路はゲート端子G-ソース端子S間およびゲート端子G-ドレン端子D間に、ショットキバリアダイオード115が接続された回路となる。

40

【0026】

静電破壊からの保護は、弱い接合であるゲート電極105のショットキ接合にかかる静電エネルギーを軽減すれば良い。そこで、本実施形態では、MESFET100の2端子間に並列に上記の保護素子200を接続し、対応する2端子間から印加される静電エネルギーに対し、それを一部放電するためのバイパスとなる経路を設けることにより、静電破壊から弱い接合を保護することとした。

【0027】

本実施形態では、図1(A) (C)の如く、ソース端子S-ゲート端子Gの2端子間とな

50

るソースバッドS P - ケートバッドG P 間と、ドレイブ端子D - ケート端子G の2端子間となるドレインバッドD P - ケートバッドG P 間に、保護素子200をそれぞれ並列に接続する。これにより、2端子が接続するボンディングバッドから印加された静電エネルギーを各配線120を使用して、保護素子200内部で、一部放電させることができる。すなわち、静電破壊強度が最も弱いFET動作領域108上の、ゲートショットキ接合に至る静電エネルギーを減少させ、FET100を静電破壊から保護することができる。ここでは、ゲート端子G - ドレイン端子D 間、およびケート端子G - ソース端子S 間の両方に保護素子200を接続して放電させるが、どちらか一方だけでもよい。

【0028】

ここで保護素子200について図2を用いて説明する。

10

【0029】

図2は保護素子を示す概要図である。

【0030】

本明細書における保護素子200とは、図の如く、近接する第1の高濃度不純物領域201と第2の高濃度不純物領域202の2端子間に絶縁領域203を配置した素子である。第1および第2の高濃度不純物領域201、202は、基板201にイオン注入及び拡散により設けられる。本明細書においては、以降これら高濃度不純物領域を、第1N+型領域201、第2N+型領域202として説明するが、これらは同じ導電型の不純物に限らず、異なる導電型の不純物でも良い。第1および第2N+型領域201、202は、静電エネルギーを通せる距離、例えば4μm程度離して設けられ、その不純物濃度は、共に $1 \times 10^{17} \text{ cm}^{-3}$ 以上である。また、第1および第2N+型領域201、202の間に絶縁領域203が当接して配置される。ここで、絶縁領域203とは、電気的に完全な絶縁ではなく、半絶縁性基板の一部、または基板201に不純物をイオン注入して絶縁化した絶縁化領域である。また、絶縁領域203の不純物濃度は、 $1 \times 10^{14} \text{ cm}^{-3}$ 以下程度、抵抗率は $1 \times 10^8 \Omega \text{ cm}$ 以上が望ましい。

20

【0031】

絶縁領域203の両端に当接して高濃度不純物領域201、202を配置し、2つの高濃度不純物領域201、202の距離を4μm程度にすると、2つの高濃度不純物領域201、202がそれぞれ接続する被保護素子の2端子間に向かって外部より印加される静電エネルギー、絶縁領域203を介して放電することができます。

30

【0032】

この2つのN+型領域の距離4μmは、静電エネルギーを通すのに適当な距離であり、10μm以上離すると保護素子間での放電が確実でない。N+型領域の不純物濃度および絶縁領域の抵抗値も、同様である。

【0033】

通常のFET動作では静電気のように高い電圧が印加されることはないため、4μmの絶縁領域を信号が通ることは無い。またマイクロ波のような高周波でも同様に4μmの絶縁領域を信号が通ることは無い。従って通常の動作では、保護素子は特性に何ら影響を及ぼさないため、存在しないのと同じである。しかし静電気は瞬間に高い電圧が印加される現象であり、そのときは4μmの絶縁領域を静電エネルギーが通り、高濃度不純物領域間で放電する。また絶縁領域の厚みが10μm以上になると、静電気にとっても抵抗が大きく放電にくくなる。

40

【0034】

これら、第1N+型領域201および第2N+型領域202を、被保護素子100の2つの端子間に並列に接続する。第1および第2N+型領域201、202はそのまま保護素子200の端子としてもよいし、更に金属電極204を設けても良い。

【0035】

図3および図4に、金属電極204を設ける場合を示す。この金属電極204は、被保護素子であるM E S F E T 100の端子と接続するボンディングバッド、またはボンディングバッドに接続する配線と接続する。図3は、第1および第2N+型領域201、202

50

とショットキ接合を形成する金属電極 204 であり、図4はオーミック接合を形成する金属電極 204である。ここでは便宜上、ショットキー接合の金属電極 204S、オーミック接合の金属電極 204Oとして説明する。

【0036】

図3(A)は、金属電極 204Sが、第1N+型領域 201および／又は第2N+型領域 202表面とショットキ接合を形成するものである。マスク合わせ精度及び両N+領域 201、202の抵抗分を考慮し、絶縁領域 203端部から 0.1μm から 5μm 間にして、第1、第2N+型領域 201、202表面に設けられる。5μm 以上離間すると抵抗分が大きく静電気が通りにくくなる。金属電極 204Sは、第1、第2N+型領域 201、202上のみに設けられても良いし、その一部が、半絶縁基板 101に延在され基板表面とショットキ接合を形成しても良い。

【0037】

また、図3(B) (C) の如く、第1、第2N+型領域 201、202上に、保護用室化膜などの線膜幅 20.5を介して金属電極 204Sを設けても良い。この場合、金属電極 204Sは半絶縁基板 101上に延在され、基板 101を介して第1、第2N+型領域 201、202と接続することになる。更に図3(D) の如く、両N+型領域 201、202の上には金属層が設けられず、その外側の半絶縁基板 101と金属電極 204Sがショットキ接合を形成する構造であってもよい。

【0038】

図3(B) (C) (D)の場合すべて、金属電極 204Sは第1、および／又は第2N+型領域 201、202とは直接接続されない。このように金属電極 204Sは第1および／または第2のN+型領域 201、202端部から 0.1μm から 5μm 程度外側で基板とショットキ接合を形成する構造でもよい。すなわち、図3(B) (C) (D)の如く第1、第2N+型領域 201、202と金属電極 204Sは接する必要はなく、5μm 以内であれば半絶縁基板を介してN+型領域と金属電極 204Sとは充分な接続を確保できる。

【0039】

一方図4には、第1及び／又は第2N+型領域とオーミック接合を形成する金属電極 204Oを示す。

【0040】

金属電極 204Oは、前記第1および／又は第2N+型領域 201、202とオーミック接合を形成してもよい。半絶縁基板 101と金属電極 204Oとはオーミック接合を形成することはできないので、この場合は隣接する基板 101上に金属電極 204Oが延在することはない。金属電極 204Oは、被保護素子のボンディングパッド（またはボンディングパッドに接続する配線）120と接続せざる、オーミック接合の場合には、図の如く、他の金属層 206を介して金属電極 204Oとパッド（または配線）120と接続せざる。

【0041】

オーミック接合の方がショットキ接合より抵抗分が小さく、静電気を通しやすい。その意味ではオーミック接合の方がショットキ接合より静電破壊からの保護効果は大きい。

【0042】

しかしオーミック接合は、オーミック電極金属 204Oが深く基板内部まで拡散することが多く、高濃度層の深さ以上にオーミック電極金属 204Oが達すると、基板の半絶縁領域とオーミック電極金属 204Oが接触することになり、このときは逆に保護素子 200自身が静電破壊しやすくなる。

【0043】

例えば第1N+領域 201、第2N+領域 202ともオーミック接合による金属が設けられ、オーミック接合どうしの距離が 10μm として、オーミック電極金属 204OがN+領域 201、202の深さ以上に基板の半絶縁領域まで拡散していたとする、N+領域の深さより深い部分ではオーミック接合—絶縁領域—オーミック接合の構造ができるあり、この構造は静電エネルギーに弱いことがわかっているため、このとき保護素子自身が静

10

20

30

40

50

電破壊してしまう恐れが出てくる。

【0044】

従ってオーミック電極金属2040がこれら2つのN+領域の深さ以上に基板の半絶縁領域まで拡散してしまう場合は、ショットキ接合でなければならず、オーミック電極金属2040がN+領域の深さにまで達しない場合はオーミック接合の方が保護効果が大きい。

【0045】

また、図4(B)の如く、保護素子200の2端子が共に同じ金属電極構造である必要はなく、第1および第2N+型領域が、それぞれ単独に、図3および図4に示す構造を有していても良い。更に一方の端子は金属電極2040を有し、他方の端子は金属電極2040を設けなくて良いが、抵抗分を小さくするためだけ設け方が良く、その分、保護効果が増す。

【0046】

尚、これら金属電極2040は、ボンディングパッドの一部またはボンディングパッドに接続する配線の一部であっても良く、後に詳述するがこれらを利用することで、保護素子200Fを接続することによるチャップ面積の増大を防ぐことができる。

【0047】

再度図1を参考して、上記の保護素子200をMESFET100の弱い接合間に並列に接続する一例を示す。

【0048】

図1(A)の保護素子のB-B線断面図は、図3(A)と同様である。このように、本明細書において保護素子200の接続とは、被保護素子100が形成される半絶縁性基板101表面に、4μmの間隔距離をもって第1N+型領域201、および第2のN+型領域202を注入・拡散により形成し、第1N+型領域201をFETの1つの端子と接続し、第2のN+型領域202をFETの他の端子と接続することをいい、被保護素子であるMESFET100と保護素子200は同一チップに集成化される。尚、基板表面が半絶縁性でない場合は、不純物イオン注入による絶縁化領域203が両N+型領域201、202の間に形成される。

【0049】

また、本明細書においては特に規定をしない限り、FETの1つの端子であるゲート端子Gに接続する保護素子200の端子を第1N+型領域201とし、他の端子となるソース端子Sおよびドレイン端子Dに接続する保護素子200の端子を第2N+型領域202として説明する。つまり、図1では、FET100に接続する保護素子200が2つあり、それぞれの第1N+型領域201が金属電極2040を介してゲートパッドGPに接続し、第2N+型領域202が金属電極2040を介してドレインパッドDPおよびソースパッドSPに接続する。金属電極2040と第1および第2N+型領域201、202はショットキ接合を形成し、金属電極2040の一部は半絶縁性基板101に延在され基板表面とショットキ接合を形成する。尚金属電極2040の構造は、一例であり図3および図4のいずれであってもよい。

【0050】

すなわち、この保護素子200は、各パッドに接続する配線120を介して1つの端子となる第1N+型領域201をゲートパッドGPに、もう1つの端子となる第2N+型領域202をソースパッドSPおよびドレインパッドDPに接続しており、FETの接合であるゲート端子G-ソース端子S間およびゲート端子G-ドレイン端子D間に並列に接続されている。

【0051】

これにより、ゲート端子G-ソース端子S間およびゲート端子G-ドレイン端子D間に印加された静電エネルギーを、保護素子200により一部放電させることができます。つまり、静電破壊強度が最も弱いFET動作領域上のゲートショットキ接合に至る静電エネルギーを大きく減衰させ、FETを静電破壊から保護することができます。放電させるのはゲート端子G-ソース端子S間、およびゲート端子G-ドレイン端子D間である。またどちら

10

30

40

50

らか一方でもよい。つまり、この構造により、保護素子を用いなければ従来構造と比較して、FETの静電破壊電圧を大幅に向上させることができる。

【0052】

従来では、ゲート端子G—ソース端子S間およびゲート端子G—ドレイン端子D間に印された静電エネルギーは、動作領域108に100%伝わっていたが、本発明によれば、各配線またはポンディングパッドを利用して、静電エネルギーを一部保護素子200にバイパスさせ、保護素子200内部で放電させることができる。これにより動作領域108に伝わる静電エネルギーを、動作領域108のゲート電極—ソース電極間およびゲート電極—ドレイン電極間の静電破壊電圧を越えない程度に減衰することができます。

【0053】

図5には、保護素子の1つの端子の金属電極にポンディングパッドを利用した例を示す。図5(A)は平面図であり、図5(B)は、C-C線断面図である。

【0054】

図1では、ソースパッドSPおよびドレインパッドDPから配線120を引き出し、その配線120に保護素子200を接続した例を示した。図5では、ソースパッドSPおよびドレインパッドDP周辺に、各ポンディングパッドのショットキ金属層210とショットキ接合を形成する第2N+型領域202を設けて、ソースパッドSP、ドレインパッドDPの一部を第2N+型領域202に接続する金属電極204として利用する構造である。

【0055】

第1N+型領域201は、第2N+型領域202と近接するよう配置され、ゲートパッドGPに接続する配線120と接続させる。このように、FETの他の端子と接続するソースパッドSP、ドレインパッドDPに直接第2N+型領域202を接続し、各パッドに近接して保護素子200を配置すると、ソース、ドレインパッドSP、DPから直接保護素子200に静電エネルギーを放電できるため静電破壊電圧を向上させる効果が大きく、更にパッド周辺のスペースを有効利用できるため、保護素子200を追加することによるチップ面積の増大を防ぐことができる。

【0056】

また図示はしないが、ゲートパッドGPに直接第1N+型領域201を接続し、更に第2N+型領域202は第1N+型領域201と近接するよう配置し、且つソースパッドSP、ドレインパッドDPに接続する配線120と接続させると、ゲートパッドから直接保護素子200に静電エネルギーを放電でき、同様に静電破壊電圧を向上させる効果が大きく、保護素子200の追加によるチップ面積の増大も防げる。

【0057】

図6は、信号経路途中に保護素子200を接続したものである。上述の如くゲート電極105のショットキ接合が最も静電破壊に弱く、実際に破壊するのは動作領域108のゲート電極105部分が最も多いため、そこで、図6の如くゲート端子Gから動作領域108のゲート電極105に至る信号経路途中に保護素子200を接続することで、最も効果的に静電破壊から保護することができる。

【0058】

この場合、第1N+型領域201は、ゲートパッドGPから動作領域108に至るゲート配線112の一部に接続する。第2N+型領域202は、ソースパッドSPおよびドレインパッドDPまたは各パッドに接続する配線120と接続する。例えば図6のゲート—ソース間では、第2N+型領域202を第1N+型領域201と近接して配置するため、第2N+型領域202の部分までソースパッドSPから配線120が延びられる。

【0059】

例えば、ゲート配線112をソースパッドSPまたはドレインパッドDPに近接するように引き回して動作領域108に接続すれば、信号経路途中で、しかもFETのパッドに近接して保護素子200を接続することができ、静電エネルギーからの保護により効果的である。

【0060】

10

20

30

40

50

ここで、図7を用いてFET100と同一基板に集成化される保護素子200の種類について説明する。上述のFET100の動作領域108は、以下の構造のいずれでも良い。図7(A)から図7(D)の各図において、左図がFETの動作領域108であり、右図が保護素子200である。

【0061】

まず図7(A)の如く、半絶縁性基板101にイオン注入により例えばN型の動作層102を設け、その両端にN+型のソース領域103およびドレイン領域104を形成して動作領域108とする。更にソース領域103、ドレイン領域104の上にオーミック電極としてソース電極106、ドレイン電極107を設け、N型の動作層102にショットキ接合するゲート電極105を設けたMESFETである。この場合保護素子200の2端子201、202は、動作領域108のソース領域103およびドレイン領域104と同時に形成すると工程を簡素化できるため好ましく、半絶縁性基板101上に4μm離間して配置する。保護素子は、第1N+型領域201-半絶縁領域203a-第2N+型領域202の構造である。この場合の保護素子200はゲートショットキ接合を静電破壊から保護する。

【0062】

図7(B)のFETは、半絶縁性基板101にイオン注入により例えばN型の動作層102を設け、その両端にN+型のソース領域103およびドレイン領域104を形成して動作領域108とする。ソース領域103、ドレイン領域104の上にオーミック電極としてソース電極106、ドレイン電極107を設け、N型の動作層102内に形成したP+型のゲート領域109にオーミック接合するゲート電極105を設けた接合型FETである。この場合、保護素子200の2端子201、202は、動作領域108のソース領域103およびドレイン領域104と同時に形成すると工程を簡素化できるため好ましく、半絶縁性基板101上に4μm離間して配置する。保護素子200は、第1N+型領域201-半絶縁領域203a-第2N+型領域202の構造である。この場合、保護素子はゲートPN接合を静電破壊から保護する。

【0063】

図7(C)のFETの動作層102は、半絶縁性基板101上に例えばN型エピタキシャル層を積層した動作層102であり、その両側にN+型不純物を注入してソース領域103およびドレイン領域104を形成する。ソース領域103、ドレイン領域104の上にオーミック電極としてソース電極106、ドレイン電極107を設け、N型の動作層102にショットキ接合するゲート電極105を設けたMESFETである。隣接する他の素子とは不純物注入による絶縁化層125で分離する。この場合、同一チップに集成化される保護素子200表面もN型エピタキシャル層であるので、第1および第2N+型領域の間は、不純物注入層による絶縁化領域203bとする。両端子の外側も絶縁のため同じく不純物注入による絶縁化層125で分離する。保護素子の絶縁化領域203bと素子分離の絶縁化層125は同一工程により形成する。又、第1および第2N+型領域201、202は動作領域108のソースおよびドレイン領域と同時に形成する。保護素子は、第1N+型領域201-絶縁領域203b-第2N+型領域202の構造である。この場合、保護素子はゲートショットキ接合を静電破壊から保護する。

【0064】

図示はないが、上記N型エピタキシャルの動作層内にP+型のゲート領域を形成し、そこにオーミック接合するゲート電極を設けた接合型FETも、図7(B)と同様に考えられる。この場合、保護素子はゲートPN接合を静電破壊から保護する。

【0065】

更に図7(D)の如く、MESFET、接合型FETに限らず、HEMT(High Electron Mobility Transistor)でも良い。

【0066】

すなわち、半絶縁性基板101に、N+AlGaAs層101a、ノンドープInGaAs層101b、N+AlGaAs層101cを順次積層した構造である。複数の層が

10

20

30

40

50

ちなる動作層 102 の両端に設けられた N+ 型のイオン注入によるソース領域 108 およびドレイン領域 104 の上に、オーミック電極としてソース電極 106、ドレイン電極 107 を設け、動作層表面にショットキ接合するゲート電極 105 を設ける。隣接する他の素子とは不純物注入による絶縁化層 126 により絶縁される。また、図 7 (D) 右図の如く、同一チップに集積化される保護素子 200 表面も同様の基板構造であるので、保護素子は、ソース領域 108 およびドレイン領域 104 と同時に形成した第 1 および第 2 N+ 型領域の間に絶縁化領域 203 b を設けた構造である。更に両端子の外側も絶縁のため同じく不純物注入による絶縁化層 126 で分離する。保護素子の絶縁化領域 203 b と素子分離の絶縁領域 126 は同一工程にて形成するとよい。また、第 1 および第 2 N+ 型領域は動作領域 108 のソースおよびドレイン領域と同時に形成すると良い。この場合、保護素子はゲートショットキ接合を静電破壊から保護する。

【0067】

ここで、FET ではゲートショットキ接合、及びゲート PN 接合が最も静電破壊に弱いため、ゲート端子 G—ソース端子 S 間、ゲート端子 G—ドレイン端子 D 間に保護素子を接続する一例を示したが、ソース端子 S—ドレイン端子 D 間に保護素子を並列に接続してもよい。

【0068】

図 8 には、その概念図を示す。接続例は一例である。例えばこの場合、ソースバッド 8 P に接続する保護素子の端子を第 2 N+ 型領域 202 とし、ドレインバッド DP に接続する保護素子 200 の端子を第 1 N+ 型領域 201 とする。第 2 N+ 型領域は、バッド周辺に設けられ、ソースバッド 8 P を金属電極 204 として利用している。

【0069】

この等価回路図は図 8 (B) である。この場合、ゲート端子 G—ソース端子 S 間のショットキバリアゲイオードとゲート端子 G—ドレイン端子 D 間のショットキバリアゲイオードが直列に接続したものを保護している。これは、例えばスイッチ回路装置のようになにソース電極とドレイン電極が両方とも入出力端子として信号の出入り口になっている場合などに、この保護素子の接続は効果がある。

【0070】

一般に GaASME8FET は衛星放送、携帯電話、無線プロードバンド用など、GHz 帯以上のマイクロ波用途に用いられる。従って良好なマイクロ波特性を確保するため、ゲート長もサブミクロンオーダーとなつてあり、ゲートショットキ接合容量が極めて小さく設計されている。そのため静電破壊に非常に弱く、GaASME8FET を集積化した MMIC を含め、その取り扱いに細心の注意が必要であった。さらに、音響、映像、電源用など周波数の低い一般民生用半導体において、静電破壊電圧を上げるため広く採用されている保護ゲイオードは、PN 接合を有するため、その使用により寄生容量が最小でも数百 fF 以上と大きく増加してしまうため、GaASME8FET のマイクロ波特性を大きく劣化させ、使用できなかった。

【0071】

しかし本発明の静電破壊保護素子 200 は PN 接合がなく、容量は大きくても数十 fF 以下となるため、GaASME8FET のマイクロ波特性を全く劣化させることなく、静電破壊電圧を大きく向上させることができるものである。

【0072】

次に、図 9 および図 10 を参照して、本発明の第 2 の実施形態について説明する。

【0073】

第 2 の実施形態は、上記の保護素子 200 を接続した FET を用いたスイッチ回路装置の一例である。

【0074】

図 9 は、被保護素子となる化合物半導体スイッチ回路装置 100 を示す回路図である。第 1 の FET 1 と第 2 の FET 2 のソース電極（あるいはドレイン電極）が共通入力端子 IN に接続され、FET 1 および FET 2 のゲート電極がそれぞれ抵抗 R1、R2 を介して

10

20

30

40

50

第2と第1の制御端子C_{T1}-1、C_{T1}-2に接続され、そしてFET1およびFET2のドレイン電極（あるいはソース電極）が第1と第2の出力端子OUT1、OUT2に接続されたものである。第1と第2の制御端子C_{T1}-1、C_{T1}-2に印加される制御信号は粗倍信号であり、Hレベルの信号が印加された側のFETがONして、共通入力端子INに印加された入力信号をどちらか一方の出力端子に伝達するようになっている。抵抗R1、R2は、交流接地となる制御端子C_{T1}-1、C_{T1}-2の直済電位に対してゲート電極を介して高周波信号が漏出することを防止する目的で配置されている。

【0076】

図9に示す回路は、図14に示すGaAs FETを用いたSPDT (Single Pole Double Throw) と呼ばれる化合物半導体スイッチ回路装置の2つのFETのゲート-ソース端子およびゲート-ドレイン端子間に並列に保護素子Z00を接続したものである。制御端子C_{T1}-1は、FET1のゲート電極に接続し、制御端子C_{T1}-2はFET2のゲート電極に接続しており、C_{T1}-1とIN間、およびC_{T1}-2とIN間、C_{T1}-1とOUT1間およびC_{T1}-2とOUT2間に、それぞれ保護素子Z00が接続されている。

【0076】

図10は、図9に示すスイッチ回路装置を1チャップに集積化した平面図を示す。

【0077】

GaAs基板101にスイッチを行なうFET1およびFET2を中央部に配置し、各FETのゲート電極317に抵抗R1、R2が接続されている。また共通入力端子IN、出力端子OUT1、OUT2、制御端子C_{T1}-1、C_{T1}-2に対応するパッドINPad、OUT1Pad、OUT2Pad、C_{T1}-1Pad、C_{T1}-2Padが基板の周辺でFET1およびFET2の周囲にそれぞれ設けられている。なお、点線で示した第2層目の配線は各FETのゲート電極317形成時に同時に形成されるゲート金属層(Ti/Pt/Au)320であり、実線で示した第3層目の配線は各素子の接続およびパッドの形成を行なうパッド金属層(Ti/Pt/Au)330である。第1層目の基板にオーミックに接続するオーミック金属層(AuGe/Ni/Au)は各FETのソース電極、ドレン電極および各抵抗両端の取り出し電極を形成するものであり、図10では、パッド金属層より重なるために図示されていない。

【0078】

図10に示したFET1は一点鍍銀で囲まれる動作領域312に形成される。下側から伸びる柳歯状の3本の第3層目のパッド金属層330が出力端子OUT1に接続されるソース電極313（あるいはドレイン電極）であり、この下に第1層目オーミック金属層で形成されるソース電極（あるいはドレイン電極）がある。また上側から伸びる柳歯状の3本の第3層目のパッド金属層330が共通入力端子INに接続されるドレン電極315（あるいはソース電極）であり、この下に第1層目のオーミック金属層で形成されるドレン電極（あるいはソース電極）がある。この両電極は柳歯をかみ合わせた形状に配置され、その間に第2層目のゲート金属層320で形成されるゲート電極317が動作領域312上に5本の柳歯形状に配置されている。なお、上側から伸びる真中の柳歯のドレン電極315（あるいはソース電極）はFET1とFET2とで共用しており、更に小型化に寄与している。ここで、ゲート幅が800μmという意味は各FETの柳歯状のゲート電極317のゲート幅の総和がそれぞれ800μmであることをいっている。

【0079】

FET1のゲート電極と制御端子C_{T1}-1は抵抗R1で接続され、FET2のゲート電極と制御端子C_{T1}-2は抵抗R2で接続されている。抵抗R1および抵抗R2は、基板に設けられたN+型不純物散逸領域である。

【0080】

前述の如くFETにおいて、最も静電破壊電圧が低いのはゲート端子Gと動作層102とのショットキ接合部分である。つまり、ゲート-ドレイン端子間、又はゲート-ソース端子間に印加された静電エネルギーが、ゲート-ショットキ接合に到達したとき、到達した静

10

30

40

40

50

電工オルギーがゲート電極とソース電極間、またはゲート電極とドレイン電極間の静電破壊電圧を上回る場合、ゲートショットキ接合が破壊に至る。

【0081】

ここで、FET 1 側と FET 2 側は対称であり、全く同様であるので、FET 1 側を例に説明する。図 14 に示す従来のスイッチ回路装置においては、共通入力端子 IN - 制御端子 C71-1 間の静電破壊電圧が 140V と最も低い。つまり、共通入力端子 IN - 制御端子 C71-1 間に印加された静電エネルギーが FET 1 のゲート電極 S17-ドレイン電極 S15 間、又はゲート電極 S17-ソース電極 S18 間に到達する前に、その到達過程において、静電エネルギーを減衰させれば良い。

【0082】

静電エネルギーを減衰させる 1 つの方法として、R1 の抵抗値を大きくする方法が考えられるが、R1 を大きくし過ぎると、スイッチ回路装置のスイッチング時間が大きくなり過ぎる。そこで、本実施形態においては保護素子 200 を用いて静電エネルギーを減衰させることとした。

【0083】

ここで、前述の如く抵抗 R1 は N+ 型不純物領域で形成されている。また、各パッドの周辺には、各パッドから高周波信号が漏れないよう、アイソレーション対策として、第 3 の高濃度不純物領域であるパッド周辺 N+ 領域 350 が配置されている。各パッドの一一番下のゲート金属層 320 は図 10 (B) の断面図の如く GaAs 半絶縁性基板とショットキ接合を形成しており、その周辺 N+ 領域 350 と各パッドはショットキ接合を形成している。

【0084】

つまり、抵抗を R1 を共通入力端子パッド INPad に近接して配置することにより、抵抗 R1 を構成する N+ 型領域と近接するパッド周辺 N+ 型領域 350 の離隔距離は 4 μm となり、半絶縁性基板 101 を挟んで保護素子 200 となる。抵抗 R1 の一部が第 1 N+ 型領域 201 であり、共通入力端子パッド INPad 周辺の N+ 領域 350 の一部が第 2 N+ 型領域 202 である。すなわち、共通入力端子 IN - 制御端子 C71-1 間、つまり FET 1 のソース-ゲート端子間（又はドレイン-ゲート端子間）に並列に保護素子 200 を接続したことになる。

【0085】

また、共通入力端子パッド INPad に近接し、尚且つ信号が印加される制御端子パッドから動作領域に至る経路途中に接続できる。これにより、スイッチ回路装置に印加された静電エネルギーを動作領域到達前に減衰させることができる。

【0086】

ここで、保護素子 200 がパッドに添って近接している距離は長い方がより多くの静電エネルギーを減衰させることができたため、10 μm 以上が望ましい。図 10 では、保護素子 200 は、共通入力端子パッド INPad 1 面に添って配置した圖を示したが、例えば抵抗 R1 の配置を変えて、共通入力端子パッド INPad の 2 面に添って L 字形状に配置すれば、パッドと近接して配置する保護素子 200 の長さを稼ぐので静電エネルギーの減衰により効果的である。

【0087】

後に詳述するが、上記の如くスイッチ回路装置の共通入力端子 IN - 制御端子 C71-1 間および共通入力端子 IN - 制御端子 C71-2 間に、並列に保護素子 200 を接続することにより、これらの端子間の静電破壊電圧を 700V まで向上させることができる。

【0088】

第 1 の実施形態の如くゲート電極-ゲートパッド間に抵抗が無い場合は、ゲート長 0.5 μm、ゲート幅 600 μm の FET であれば、ゲート-ソース間やゲート-ドレイン間の静電破壊電圧を測定すると 50V 程度以下である。すなわち FET の動作領域上のゲートショットキ接合とのものの静電破壊電圧の実力値は 50V 程度以下といえる。

【0089】

10

20

30

40

50

第2の実施形態のFETもゲート長0.6mm、ゲート幅600μmであり、通常このFETのゲートショットキ接合の静電破壊電圧も50V程度以下である。しかし、Siイチ回路装置には必ず第2の実施形態のようなゲート電極—ゲートパッド（この場合制御端子パッド）間に抵抗R1、R2が存在する。この抵抗R1、R2で、静電工エネルギーが一部熱となって消費されるため、Siイチ回路装置として共通入力端子IN—制御端子C71—1間に（以下共通入力端子IN—制御端子C71—2間も同様）の静電破壊電圧を測定すると、保護素子Z200を接続しなくとも多少静電破壊電圧は向上し、100V程度以下となる。

【0090】

そこでさらに保護素子Z200を並列に接続すると、静電工エネルギーがバイパスされ保護素子Z200で放電される。つまり、保護素子Z200により放電される静電工エネルギー分が更に追加で、共通入力端子IN—制御端子C71—1間に印加されても、動作領域312が静電破壊することはなくなり、保護素子Z200により放電する分だけ、静電破壊電圧の測定値が大きくなり200V以上となる。

【0091】

換言すれば、共通入力端子IN—制御端子C71—1間に印加される静電工エネルギーを、抵抗R1で一部熱として消費しながら、さらに保護素子Z200での放電により消費し、動作領域312に達するまでに、動作領域312の破壊電圧今まで減衰することができます。

【0092】

図11には、第2の実施形態である図10のSiイチ回路装置の静電破壊耐圧を測定した結果を示す。これによると、共通入力端子IN—制御端子C71—1間および共通入力端子IN—制御端子C71—2間の静電破壊電圧が700Vとなり、従来の同じ端子間で40Vであったことと比較すると大幅に向上している。

【0093】

このメカニズムを、FETの動作領域312の静電破壊電圧の実力値が例えば50Vとして説明する。

【0094】

FETの動作領域312は上述の如く50Vで破壊する。また、従来は、共通入力端子IN—制御端子C71—1間に静電破壊電圧は、図15に示す140Vである。これは、保護素子Z200を設げず、共通入力端子IN—制御端子C71—1間に印加される静電工エネルギーが一部抵抗R1で漏洩しながら動作領域312に達する場合の値である。つまり $140 - 50 = 90$ V分の静電工エネルギーが、ゲート電極S17—制御端子パッドC71—1Pad間に抵抗R1で、熱として消費され、FETの動作領域312に50Vが印加された時点までFETのショットキ接合が破壊していくことになる。

【0095】

第2の実施形態では、図11の如く共通入力端子IN—制御端子C71—1間で、静電破壊電圧を測定したとき700Vで破壊する。FETの動作領域312のショットキ接合は50Vで破壊し、ゲート電極S17—制御端子パッドC71—1Pad間に抵抗R1で、熱として消費される静電工エネルギーは90V分であり、これは従来同様である。

【0096】

すなわち、 $700 - 50 - 90 = 560$ V分の静電工エネルギーが保護素子Z200で放電され、これも熱となって消費されたことになる。つまり、第2の実施形態のパターンによれば、動作領域312のショットキ接合の静電破壊電圧分+抵抗R1での漏洩分を越えた分(560V)を保護素子Z200で放電でき、動作領域312に至るまで静電工エネルギーを漏洩さるので、静電破壊電圧が700Vまで向上したといえる。

【0097】

ここで、共通入力端子パッドINPad、制御端子C71—1Pad、C71—2Pad、出力端子OUT1Pad、OUT2Padおよび両FETの動作領域312を除くゲート電極の周端部の下にも、一点破線で示す如く周辺N+型領域350が設けられている。

10

20

30

40

50

周辺N+型領域850は周辺部だけでなく、各パッドおよび両FETの動作領域を除くゲート電極817直下全面に設けられてもよい。これら周辺N+型領域850は、ソースおよびドレイン領域形成と共に形成されたものであり、これら周辺N+型領域850および抵抗R1、R2が互いに隣接する部分の距離は4μmとなっている。

【0098】

つまり、これらの周辺N+型領域850と抵抗R1、R2とを保護素子200の端子として、同一チャップ内に複数接続することができる。保護素子200の端子は、金属電極を介してボンディングパッドと接続しても良いし、ボンディングパッドと動作領域812とを接続する抵抗R1、R2などの配線とのものであっても良い。

【0099】

図10の例えはFET1側では、抵抗R1を、共通入力端子パッドINPadの近傍と、出力端子パッドOUT1Padの近傍を通るように配置している。これにより、FET1のゲートードレイン端子間、ゲートーソース端子間の両方に保護素子200が接続されることになり、スイッチ回路装置の最低の静電破壊電圧を向上させることができる。

【0100】

図11によれば、制御端子C71-1-1出力端子OUT1間および制御端子C71-1-2出力端子OUT2間の静電破壊電圧は830Vである。静電破壊電圧を決めるメカニズムの詳細はまだ不明の部分が多く、この端子間にかけて静電破壊電圧が従来よりも低減する理由は明らかでない。しかし、重要なポイントは、被保護素子全体の静電破壊電圧は、当該被保護素子の2端子間の組み合わせのうち、最も低い静電破壊電圧に支配されるため最も低い静電破壊電圧値をどこまで上げることができるかである。

【0101】

本実施形態に於いては、従来最も低い静電破壊電圧であった共通入力端子IN-制御端子C71-1-1間および共通入力端子IN-制御端子C71-1-2間に保護素子を並列に接続することにより、静電破壊電圧を700Vに向上することができる。

【0102】

加えて、制御端子C71-1-1出力端子OUT1間および制御端子C71-1-2出力端子OUT2間に保護素子を接続することにより、従来の最低静電破壊電圧であった140Vが830Vに向上去しており、スイッチ回路装置全体として、静電破壊電圧を向上できる効果がある。

【0103】

また、図12に第8の実施形態を示す。図12は、図10の化合物半導体スイッチ回路装置のリバースコントロールタイプのロジックパターンの回路構成であり、制御端子C71-1は、FET2のゲート電極に接続し、制御端子C71-2はFET1のゲート電極に接続する。

【0104】

このスイッチ回路のロジックでは、出力端子OUT1に信号を送るとには出力端子OUT1から遠い制御端子C71-1に8V、制御端子C71-1に0Vを印加し、逆に出力端子OUT2に信号を送るとには出力端子OUT2から遠い制御端子C71-1に8V、C71-2に0Vのハイアス信号を印加している。

【0105】

このリバースコントロールタイプのスイッチ回路装置においては、入力端子IN-制御端子C71-1-2間に保護素子200を接続する。これにより、例えは接続前に80Vと最も低い静電破壊電圧であった2端子間の静電破壊電圧を270Vまで向上することができる。

【0106】

また、図の如く、FET1のゲートードレイン端子間(C71-2-IN間)、FET1のゲートーソース間(C71-1-OUT1間)、FET2のゲートードレイン間(C71-1-1IN間)、FET2のゲートーソース間(C71-1-1-OUT2間)に夫々保護素子200を接続すると、従来80Vであったスイッチ回路装置の最も低い静電破壊電圧

10

20

30

40

50

を270Vに向上させることができます。

【0107】

この場合、共通入力端子パッドINPadはFET1、FET2の2つのFETの共通パッドとなっており、各制御端子はそれぞれ違った位置にあるFETと接続する。このため、一例であるが、その接続手段である抵抗R1、R2は、それぞれ入力端子パッドINPadにL字型で、4辺とも近接して配置される。つまり入力端子パッドINPadに沿って、2つの保護素子Z00がそれぞれL字形状に接続した構造となっている。

【0108】

このように、複数の保護素子Z00がそれぞれ、同一パッドの少なくとも1辺に添って配置されても良い。

10

【0109】

上述の実施形態に示す接続例は一例である。パッド同士が近接するような場合は、保護素子の両端子とも、パッドに直接接続するN+領域とすることも可能である。すなわち、請求の範囲の記載によってのみ、規定されるものである。

【0110】

【発明の効果】

以上に詳述した如く、本発明に依れば以下の数々の効果が得られる。

【0111】

第1に、静電破壊しやすい、PN接合又は、ショットキ接合を含むFETの特に弱い接合となる端子間に、高濃度領域一絶縁領域一高濃度領域からなる保護素子を並列接続することにより、外部より印加される静電エネルギーをバイパスさせることができます。これによりFETの動作領域に至る経路途中で保護素子により静電エネルギーが放電されるので、保護素子が接続された端子間に對応する動作領域上の電極間に至る静電エネルギーが漏洩し、静電破壊からFETを保護することができます。

20

【0112】

第2に、保護素子は、高濃度領域一絶縁領域一高濃度領域からなり、PN接合を有さないため、保護素子自身の寄生容量が発生しない。被保護素子と同一基板で保護素子を作りこむことができ、寄生容量の増加をほとんど伴わず、従って高周波特性を劣化させずに、被保護素子の静電破壊を防ぐことができます。

【0113】

第3に被保護素子の端子と接続するパッドに近接して保護素子を接続することにより、静電エネルギーの印加直後に放電することができ、より静電破壊電圧の向上に寄与できる。

30

【0114】

第4に、被保護素子の端子から動作領域への経路途中に保護素子を接続することにより、最も効果的に、動作領域の静電破壊に弱い接合を静電破壊から保護できる。

【0115】

第5に、スイッチ回路装置においては、従来最も低い静電破壊電圧であった共通入力端子と制御端子間に保護素子を並列に接続することにより、共通入力端子一制御端子間の静電破壊電圧を大幅に向上することができます。

40

【0116】

第6に、スイッチ回路装置において制御端子一出力端子間に保護素子を接続することにより、スイッチ回路装置全体の最低静電破壊電圧を向上できる効果がある。

【0117】

第7に、保護素子は、静電エネルギーを放電する面が、水平面となる保護ダイオードと異なり、垂直面になるため、チップ面積の増大をほとんど招くことなく、これを集積化することができまするものである。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明を説明するための(A)平面図、(B)断面図、(C)等価回路図である。

【図2】本発明を説明するための概略図である。

50

- 【図 8】本発明を説明するための断面図である。
 【図 4】本発明を説明するための断面図である。
 【図 5】本発明を説明するための(A)平面図、(B)断面図である。
 【図 6】本発明を説明するための平面図である。
 【図 7】本発明を説明するための断面図である。
 【図 8】本発明を説明するための(A)平面図、(B)等価回路図である。
 【図 9】本発明を説明するための等価回路図である。
 【図 10】本発明を説明するための(A)平面図、(B)断面図である。
 【図 11】本発明を説明するための特性図である。
 【図 12】本発明を説明するための平面図である。
 【図 13】従来技術を説明するための等価回路図である。
 【図 14】従来技術を説明するための平面図である。
 【図 15】従来技術を説明するための特性図である。

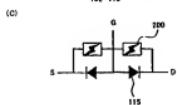
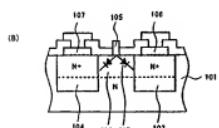
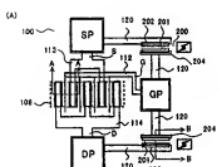
【符号の説明】

100	被保護素子	
101	基板	10
102	動作層	
103	ソース領域	
104	ドレイン領域	
105	ゲート電極	
106	ソース電極	
107	ドレイン電極	
112	ゲート配線	
113	ソース配線	
114	ドレイン配線	
115	ダイオード	
120	配線	
125	絶縁化層	
200	保護素子	
201	第1N+型領域	20
202	第2N+型領域	
203	絶縁領域	
203a	半絶縁領域	
203b	絶縁化領域	
204	金属電極	
205	絶縁膜	
206	金属層	
312	動作領域	
313	ソース電極	
315	ドレイン電極	40
317	ゲート電極	
320	ゲート金属層	
330	パッド金属層	
350	周辺N+型領域	
6	ソース端子	
D	ドレイン端子	
G	ゲート端子	
S P	ソースパッド	
D P	ドレインパッド	
G P	ゲートパッド	50

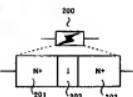
I N	共通入力端子
C t l - 1	制御端子
C t l - 2	制御端子
O U T 1	出力端子
O U T 2	出力端子
I N P a d	共通入力端子パッド
C t l - 1 P a d	制御端子パッド
C t l - 2 P a d	制御端子パッド
O U T 1 P a d	出力端子パッド
O U T 2 P a d	出力端子パッド

10

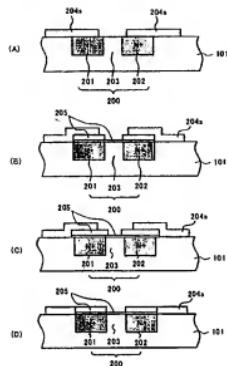
【図 1】



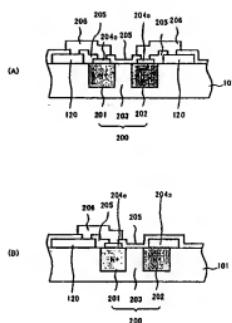
【図 2】



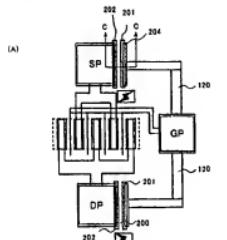
【図8】



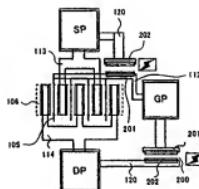
【図4】



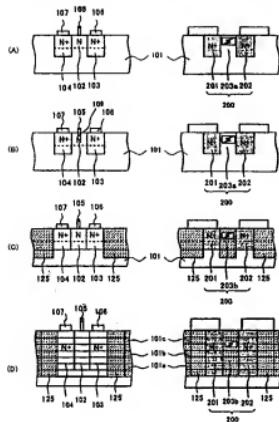
【図5】



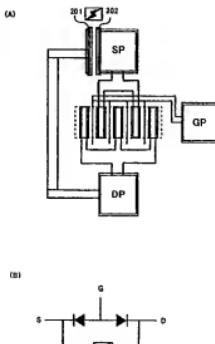
【図6】



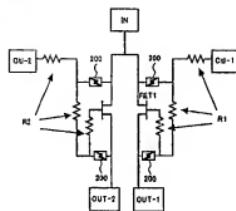
[7]



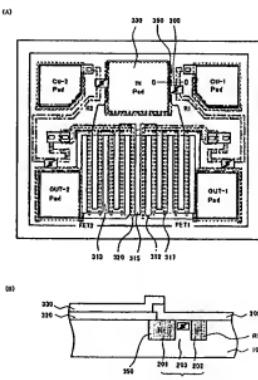
- [图-8-]



【 9 】



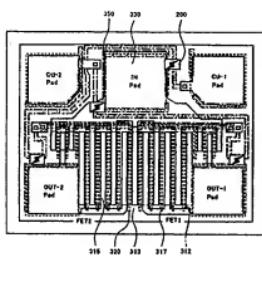
【四 10】



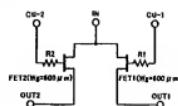
【図11】

各端子間の静電容量(単位F)	
DH-DU-1	700
DH-DU-2	700
DUT1-DU-1	330
DUT2-DU-2	330

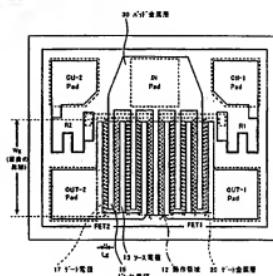
【図12】



【図13】



【図14】



【図15】

各端子間の静電容量(単位F)	
DH-DU-1	140
DH-DU-2	140
DUT1-DU-1	500
DUT2-DU-2	450

フロントページの続き

Fターム(参考) 5F038 AR01 BE07 BH01 BH02 BH13 CA09 CA10 DF02 EX02 EX20
5F102 FA06 GA01 GA17 GB01 GC01 GD01 GD04 GJ05 GK06 GL04
GM06 GG01 GR07 GR09 GS09 HC07